

## Характеристики наборов биполярных транзисторов

$I_{CBO}$	Обратный ток коллектора	$\Delta h_{21E}$	Разброс статических коэф. пер. тока
$I_{EBO}$	Обратный ток эмиттера	$U_{BESAT}$	Напряжение насыщения база-эмиттер
$I_{TIT20}$	Ток утечки между транзисторами	$U_{CESAT}$	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
$h_{21E}$	Стат. коэф. пр. пер. т. в сх. с общ. эм. в реж. бол. сиг.	$\Delta U_{BE}$	Разброс напряжения база-эмиттера

Тип	Параметр								Тип корпуса	Технические условия	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Кол-во транзисторов	
	$I_{CBO}, \text{нА}$	$I_{EBO}, \text{нА}$	$h_{21E}$	$I_{TIT20}, \text{нА}$	$\Delta h_{21E}$	$U_{BESAT}, \text{В}$	$U_{CESAT}, \text{В}$	$\Delta U_{BE}, \text{В}$							
198НТ1А	<50	<100	30;200	<50	<15	<0,8	<0,2	3	401.14-5	АЕЯР.431410.245ТУ	СА3046	Матрица транзисторо в NPN типа	-60 ; - ; +125	5	
198НТ1Б			-					10							
198НТ1В			-					3							
198НТ2А			30;200					<0,1							10
198НТ2Б			-					-							
198НТ3	<75	30;250	<0,85	<0,5	5	-									
198НТ5А	<100			<0,75											
198НТ5Б	<75			<0,5											
198НТ6А	<100			<0,75											
198НТ6Б	<75			<0,5											
198НТ7А	<100			<0,75											
198НТ7Б	<75			<0,5											
198НТ8А	<100			<0,75											
198НТ8Б	<75			<0,5											
198НТ8Б	<100			<0,75											